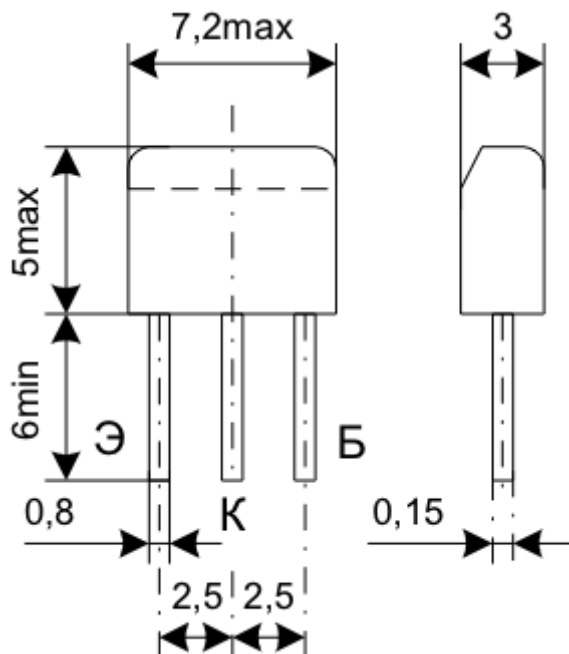


КТ315Д

Транзисторы кремниевые эпитаксиально-планарные структуры n-p-n усилительные. Область применения: элементы логики, генераторы и усилители высокой, промежуточной и низкой частоты.

Выпускаются в пластмассовом корпусе желтого, красного, тёмно-зелёного и оранжевого цветов с гибкими выводами.



Тип прибора указывается на корпусе полностью, либо в виде буквы соответствующего типономинала в левом верхнем углу лицевой части корпуса прибора напротив вывода эмиттера. Масса транзистора не более 0,18 г.

Тип корпуса: КТ-13. Технические условия: ЖКЗ.365.200 ТУ.

Основные технические характеристики транзистора КТ315Д:

- $P_{к\max}$ - Постоянная рассеиваемая мощность коллектора: не более 150 мВт;
- $f_{гр}$ - Граничная частота коэффициента передачи тока транзистора для схемы с общим эмиттером: не менее 250 МГц;
- $U_{кэ\max}$ - Максимальное напряжение коллектор-эмиттер при $R_{бэ}=10\text{ кОм}$: 40 В;
- $U_{бэ\max}$ - Максимальное напряжение база- эмиттер: 6 В;
- $I_{к\max}$ - Максимально допустимый постоянный ток коллектора: 100 мА;
- $I_{к}$ - Обратный ток коллектора при $U_{кб}=10\text{ В}$: не более 1 мкА;
- $I_{кэо}$ - Обратный ток коллектор-эмиттер при $U_{кэ}=40\text{ В}$, $R_{бэ}=10\text{ кОм}$: не более 1 мкА;
- $I_{эо}$ - Обратный ток эмиттера при $U_{эб}=5\text{ В}$: не более 50 мкА;
- $h_{21э}$ - Статический коэффициент передачи тока транзистора для схем с общим эмиттером: 20...90;
- $C_{ск}$ - Емкость коллекторного перехода: не более 7 пФ.